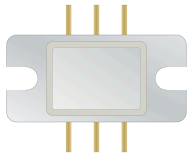
4000–5000 MHz GaN パッケージ型パワーアンプ — PSAT ≥ 45 dBm

LCI-PA-4000-5000-PS45MIN · 4000–5000 MHz · GaN パッケージ型パワーアンプ.

RF 電気特性表の規定値: PSAT ≥ 45 dBm; 電力利得 ≥ 26 dB; PAE 50 % (標準値). RF 測定条件: Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; D = 10%; Pin = 19 dBm.



CMW010B

ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

パッケージ外形寸法: 18.03 × 8.7 mm.

RF 特性

Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; D = 10%; Pin = 19 dBm

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	f	4000	-	5000	MHz
飽和出力電力	-	45	-	-	dBm
電力利得	-	26	-	-	dB
電力付加効率	-	40	50	-	%
電力利得平坦度	-	-	-	±0.5	dB

DC バイアスと電流

項目	記号	最小値	代表値	最大値	値	単位
ドレイン電圧	-	-	-	-	28	V
ゲート電圧	-	-	-	-	-3.05	V

絶対限界値

限界値であり、通常動作の設定値ではありません。

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大ドレイン・ソース間電圧	-	-	-	32	V
ゲート・バイアス下限	-	-5	-	-	V
保存温度	-	-65	-	150	°C
最大入力電力	-	-	-	24	dBm

パッケージ外形寸法

項目	値	単位
パッケージ外形寸法	18.03 × 8.7	mm
端子全幅	14.7	mm

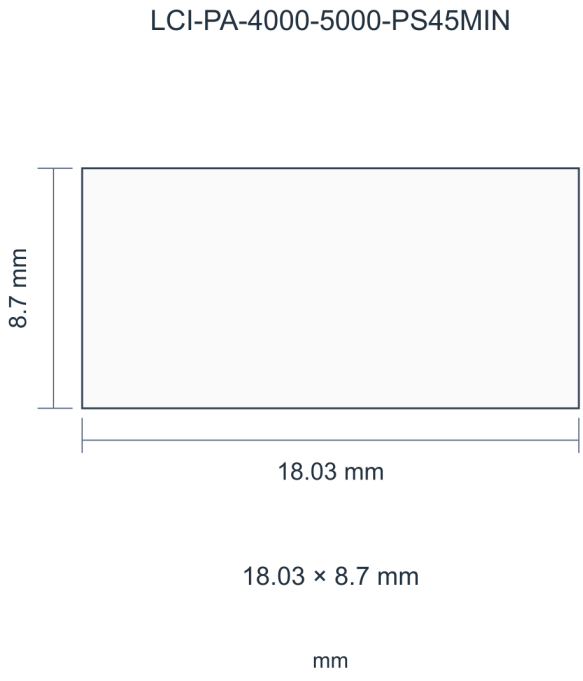
現在の発行記録 · 1.6 · 2026-11-12. 製品説明または編集内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.5.

実装上の注意

CMW010B ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。 Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

外形寸法図

確認済みの寸法を mm で示した部分図です。取り付けには、完全な取付図を参照してください。

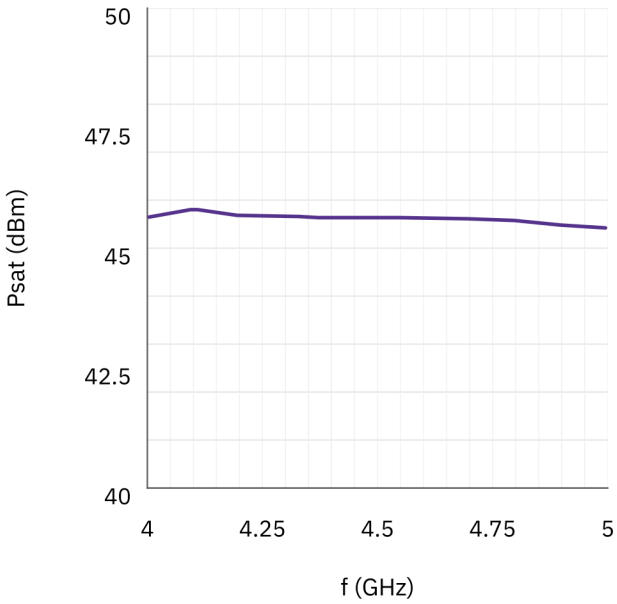


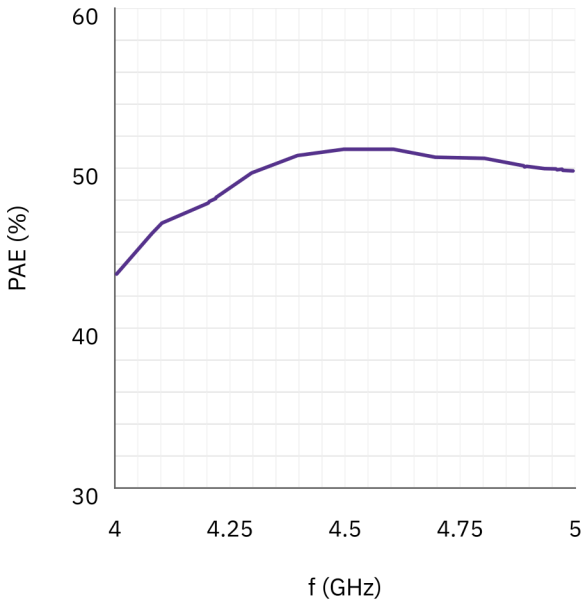
性能特性曲線

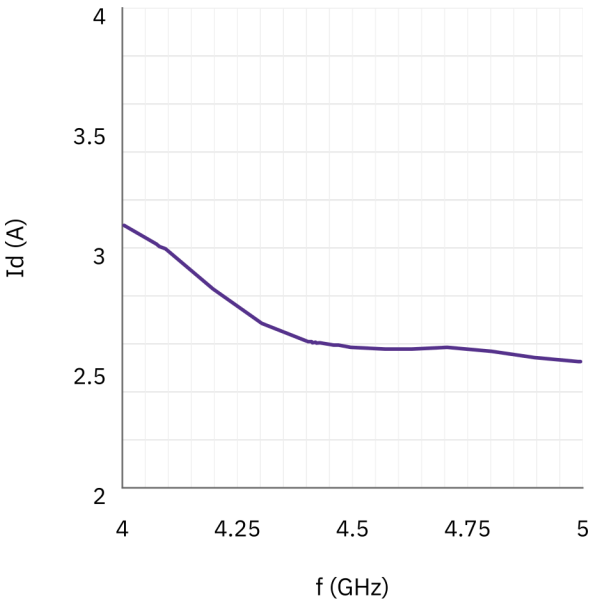
各性能グラフは、図中に示す動作条件における特性を表しています。

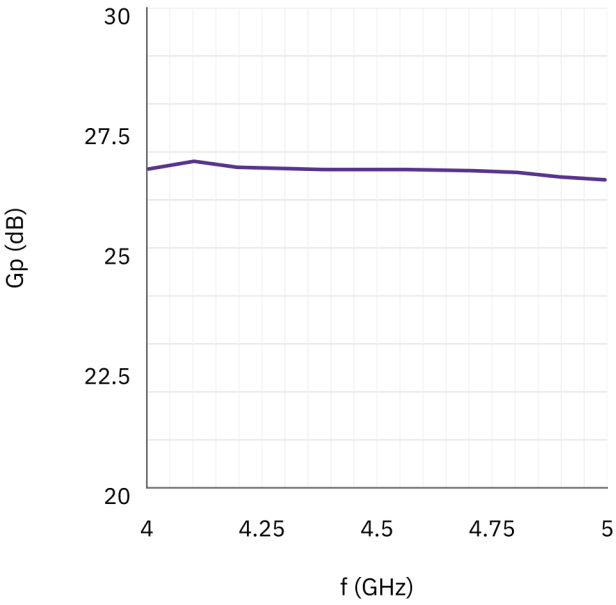
飽和出力電力、電力付加効率、ドレイン動作電流、電力利得。

図の注記：TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.8V; Pin=19dBm。 読み取り値は近似値です。 デューティ比 = 10%。



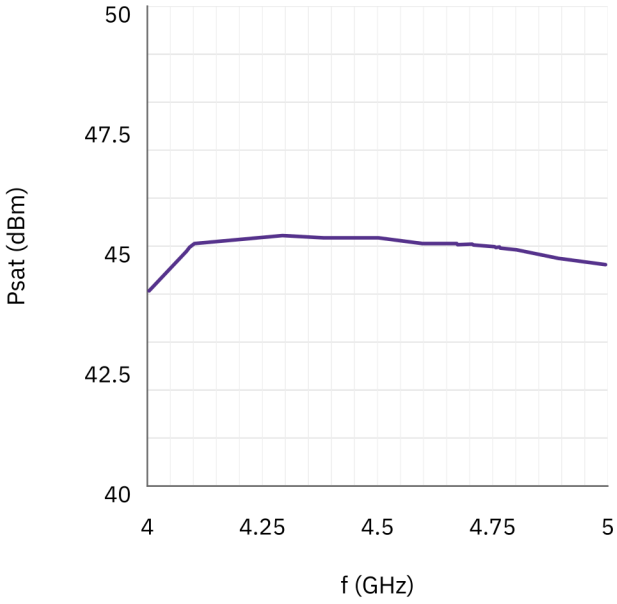


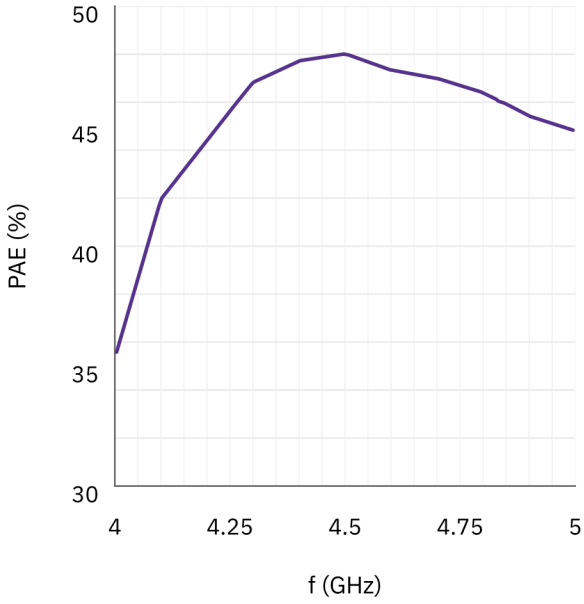


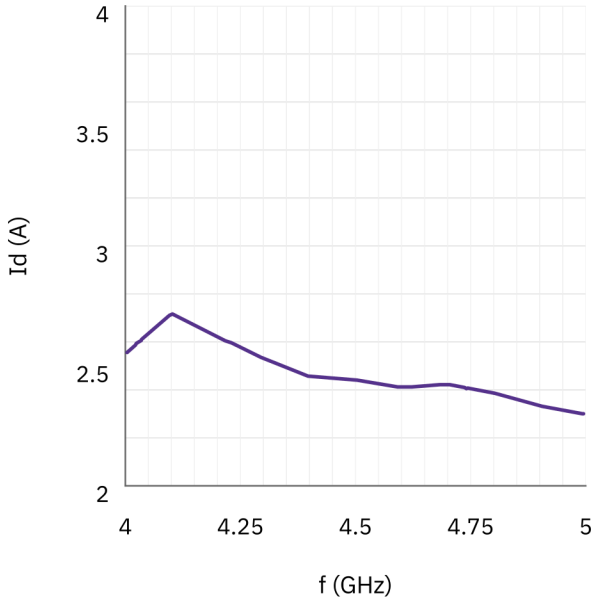


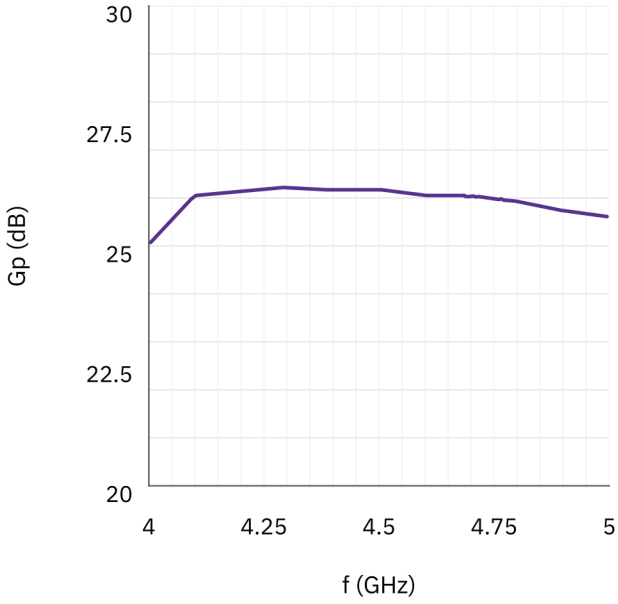
連続波（CW） – 飽和出力電力、電力付加効率、ドレイン動作電流、電力利得。

図の注記：TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.8V; Pin=19dBm。 読み取り値は近似値です。









文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。